



Toshiba lance un double MOSFET 30 V complémentaire destiné aux équipements grand public et industriels plus compacts et plus économes en énergie

Ce double MOSFET à canal N et canal P, en boîtier TSOP6F compact, offre une résistance à l'état passant faible et bien équilibrée, ce qui simplifie la conception des circuits

Düsseldorf, Allemagne, 2 juin 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») lance le [SSM6L826R](#), un nouveau MOSFET double 30 V intégrant des MOSFET à canal N et à canal P dans un seul boîtier. Ce produit est idéal pour des applications telles que la commande de moteurs monophasés sans balais (*brushless DC*, BLDC), la commande de moteurs à courant continu à balais et la commutation de charges pour les lignes d'alimentation des équipements de commande grand public et industriels.

Le SSM6L826R utilise le procédé UMOSVIIH de Toshiba pour le MOSFET à canal N et le procédé UMOSVI pour le MOSFET à canal P. Il est logé dans un boîtier TSOP6F compact (2,9 mm × 2,8 mm × 0,8 mm) avec des broches plates pour faciliter le montage.

Le dispositif atteint de faibles valeurs de résistance drain-source à l'état passant ($R_{DS(ON)}$) de 46 mΩ (max.) ($V_{GS} = 10$ V) pour le MOSFET à canal N et de 45 mΩ (max.) ($V_{GS} = -10$ V) pour le MOSFET à canal P. Comme les valeurs de $R_{DS(ON)}$ sont quasiment identiques, les pertes par conduction restent bien équilibrées, ce qui simplifie le développement des circuits. De plus, l'intégration des deux types de MOSFET dans un seul boîtier permet de réduire la surface du circuit imprimé, le nombre de composants et le coût de la nomenclature.

Avec le lancement du SSM6L826R, Toshiba élargit sa gamme de MOSFET doubles TSOP6F en y intégrant trois MOSFET doubles à canal N, un MOSFET double à canal P et

deux MOSFET complémentaires (N+P), offrant ainsi aux ingénieurs une plus grande flexibilité pour choisir le composant le mieux adapté à leurs conceptions.

Toshiba continuera d'élargir sa gamme de MOSFET afin de répondre à la demande croissante d'une efficacité accrue, de pertes réduites et d'une miniaturisation accrue des équipements, tant sur le marché grand public qu'industriel.

Pour plus d'informations sur le SSM6L826R, veuillez consulter: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/detail.SSM6L826R.html>

###

À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres. En outre, TEE propose également des cellules et des modules de batterie SCiB™ avec de l'oxyde de lithium et de titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à www.toshiba.semicon-storage.com et www.scib.jp/en pour plus d'informations sur la société et ses produits.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com